

株式会社産業革新機構(INCJ)がGENUSIONへの投資を実施

次世代フラッシュメモリ技術を持ち、製品化開発を行っている株式会社 GENUSION (ジェニュージョン、兵庫県尼崎市道意町、代表取締役 中島盛義、以下、「GENUSION」)は、5月12日に株式会社産業革新機構(東京都千代田区丸の内、代表取締役社長 能見公一、以下「INCJ」)による GENUSION への投資が実施された事を発表いたします。

GENUSION の中核技術は、次世代フラッシュメモリ技術である B4-Flash メモリです。大手半導体メーカーの出身である GENUSION の技術者が中心となり、大阪大学、東北大学やインド工科大学との共同開発(オープンイノベーション)により開発してきました。B4-Flash メモリは、GENUSION の発明による新しいフラッシュメモリの動作原理である B4-HE(Back Bias assisted Band to Band tunneling Hot Electron injection)書込み方式により、従来のプログラム保存用フラッシュメモリが持つ微細化限界を打破し、大幅な低コスト化と同時に高速書込みを実現しました。また、従来のフラッシュメモリとは異なる P チャンネル MOS トランジスタによるメモリ素子を導入することにより、従来技術では困難であった多数回書換後の高温での長期間安定データ保持を実現しました。

GENUSION は、こうした技術を基に、低コストで大容量のプログラム保存用フラッシュメモリを必要とする用途や書換後に高温での長期間データ保持が必要なフラッシュメモリ分野を狙い、当面、家電、自動車用途、携帯電話、アミューズメント、ゲーム機器などのグローバル市場を開拓することを目指します。そのため、GENUSION としては自社技術による技術の研究開発と製品化に注力し、生産にかかわる半導体製品の組立・テスト技術開発や大量生産については大手企業などと連携することにより生産工程を保有しないファブレス・メモリ・メーカーとして事業を進めます。また販売・商流については大手半導体商社と連携し、事業の拡大を可能とします。

INCJは、GENUSION の事業が、国内外の大学とのオープンイノベーションで得られた革新的な次世代フラッシュメモリ技術を基に、大手企業などとの協業によって成長市場の開拓を行なう本格的なファブレス・ベンチャー企業であると判断し、投資を実施しました。INCJ は、今回の投資により GENUSION が行なう顧客と連携した製品開発を支援すると同時に、国内外の大手企業を中心とする生産・販売パートナーとの関係構築や、国際展開を加速するための外部人材の登用等の社内体制の充実を早期に実現することを目指します。

株式会社産業革新機構(INCJ)について

INCJは、2009年7月にオープンイノベーションの推進を通じた次世代産業の育成を目指して、法律に基づき設立された会社です。総額8000億円超の投資能力を有しており、革新性を有する事業に対して出資等を行なうことで産業革新を支援することをミッションとしています。

(INCJ のホームページはこちら)

株式会社GENUSIONについて

GENUSION は 2002 年に設立され、フラッシュメモリにおける革新的技術を開発しています。GENUSION の製品は独自技術である B4-Flash メモリ技術と SiP(System in Package)設計技術に基づき、先端半導体メーカー、アセンブリ・テストメーカー、商社などとの協業の下に実現されます。